

LV Power Report No.3

LV2-PE-KIT MC ヘッドアンプの SN 比向上裏技

2015 年 1 月 5 日 Linkman-Audio 開発部

LV2-PE-KIT は、おかげさまで第 1 ロットが完売しました。

完売御礼として、ここでは性能向上の裏技をご紹介します。

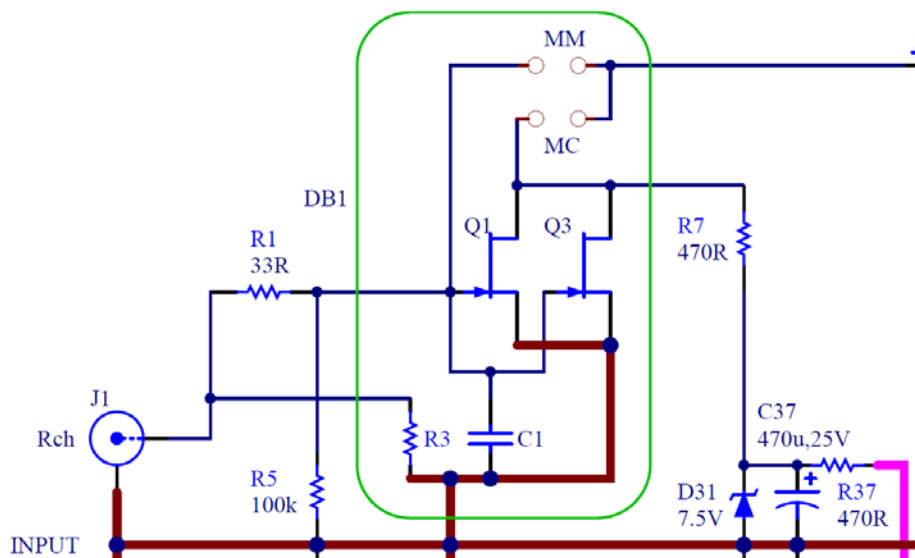
MC ヘッドアンプは、JFET 1 石のゼロバイアス方式を採用していますが、この方式は音質の良さと引き換えに JFET の I_{DSS} のバラツキによってゲインが変わることから、本キットでは JFET を 4 個付属し、2 個を選別して使うように推奨されています。

基板の方には他の JFET も利用できるように 4 個付けられるようになっていますが、付属の 2SK170 を 4 個とも付けた場合にはどうなるのか？と疑問を持たれた方も多いと思います。

答えは、高い確率で問題無く動作します。しかも SN 比は約 3dB アップします！

2SK170 の I_{DSS} の最大値は 6.5mA です。チャンネル当たり 2 個とも 6.5mA のものであった場合には、R7 での電圧降下が 6.11V となり、各 부품のバラツキを含めると JFET のドレインソース間電圧が小さくなり過ぎ性能が取れなくなる恐れがあります。しかし、 I_{DSS} の Max 値近くのもものが 4 個も同梱される確率は非常に低く、ほとんどの方がこの裏技を体験できると思います。(もし、運悪く I_{DSS} の大きなものに当たってしまった人は、ごめんなさい！)

なお、4 個付ける場合も、R7 に掛かる電圧がチャンネル間で近くなるように、JFET を組み合わせてください。



本件について、お問い合わせは下記までお願いいたします。

Mail : info@linkman.jp